PCT WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

International Bureau

INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International patent classification[6]: H01L 21/762 // 21/20, 21/322 — A1

(11) International publication number: WO 99/52145

(43) International publication date: 14 October 1999 (14.10.99)

(21) International application number: PCT/FR99/00786

(22) International filing date: 6 April 1999 (06.04.99)

(30) Data relating to the priority:
98/04,299 7 April 1998 (07.04.98) FR

(71) Applicant *(for all designated States except US)*: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants *(US only)*: MALEVILLE, Christophe [FR/FR]; 159, chemin du Diday, F-38360 Noyarey (FR). BARGE, Thierry [FR/FR]; 38, rue Félix Esclangon, F-38000 Grenoble (FR). ASPAR, Bernard [FR/FR]; 110, lotissement du Hameau des Ayes, F-38140 Rives (FR). MORICEAU, Hubert [FR/FR]; 26, rue du Fournet, F-38120 Saint-Egrève (FR). AUBERTON-HERVE, André-Jacques [FR/FR]; 94, avenue de Karben, F-38120 Saint-Egrève (FR).

(74) Representatives: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).

(81) Designated states: JP, KR, SG, US, European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Published
With the International Search Report.

As printed

(54) Title: HEAT TREATMENT METHOD FOR SEMICONDUCTOR SUBSTRATES

(54) Titre: PROCEDE DE TRAITEMENT THERMIQUE DE SUBSTRATS SEMI-CONDUCTEURS

(57) Abstract

The invention concerns a method for treating a substrate comprising a semi-conducting layer (4) on at least one of its surfaces. Said method comprises a step for annealing the substrate and a step for forming an oxide layer (6) at the semi-conducting layer (4) surface, carried out before the end of the annealing step, protecting the remainder of the semi-conducting layer (4).

(57) Abrégé

L'invention concerne un procédé de traitement d'un substrat comportant une couche de semi-conducteur (4) sur au moins une de ses faces. Ce procédé comprend une étape de recuit du substrat et une étape de formation d'une couche d'oxyde (6) en surface de la couche de semi-conducteur (4), réalisée avant la fin de l'étape de recuit, protégeant le reste de la couche de semi-conducteur (4).

